

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 28 卷 第 9 期 2007 年 9 月

目 次

研究快报

- Ti/4H-SiC Schottky Barrier Diodes with Field Plate and B⁺ Implantation Edge Termination Technology Chen Gang, Li Zheyang, Bai Song, and Ren Chunjiang (1333)
- Driving Circuit for AMOLED with Fault Tolerance Li Dayong, Liu Ming, and Wei Wang (1337)
- A High Speed, 12-Channel Parallel, Monolithic Integrated CMOS OEIC Receiver Zhu Haobo, Mao Luhong, Yu Changliang, Chen Hongda, and Tang Jun (1341)
- A Novel Power Supply Solution of a Passive RFID Transponder Jia Hailong, Ni Weining, Shi Yin, and Dai F F (1346)

研究论文

- Subsurface Damage in the Monocrystal Silicon Grinding on Atomic Scale Guo Xiaoguang, Guo Dongming, Kang Renke, and Jin Zhuji (1353)
- A Novel Fully-Depleted Dual-Gate MOSFET Zhang Guohe, Shao Zhibiao, Han Bin, and Liu Derui (1359)
- CMOS Quadrature Modulator and Up-Conversion Mixer for 802.11a Wireless LAN Systems Li Wenyuan, Wang Zhigong, and Mao Yinwei (1364)
- Mismatch Calibration Techniques in Successive Approximation Analog-to-Digital Converters Wang Pei, Long Shanli, and Wu Jianhui (1369)
- Combined Novel Gate Level Model and Critical Primary Input Sharing for Genetic Algorithm Based Maximum Power Supply Noise Estimation Tian Zhixin, Liu Yongpan, and Yang Huazhong (1375)
- 铁硅化合物 β -FeSi₂ 带间光学跃迁的理论研究 闫万珺 谢 泉 张晋敏 肖清泉 梁 艳 曾武贤 (1381)
- 掺 Er HfO₂ 薄膜材料的光致发光性质 夏 艳 王军转 石卓琼 施 毅 濮 林 张 荣 郑有料 陶镇生 陆 昉 (1388)
- InGaN 太阳能电池转换效率的理论计算 文 博 周建军 江若琏 谢自力 陈敦军 姬小利 韩 平 张 荣 郑有料 (1392)
- 化学氧化法聚吡咯导电性能与导电机理 任 丽 张雪峰 王立新 张福强 (1396)
- Ag 层的厚度对 ZnO/Ag/ZnO 多层膜性能的影响 李 俊 闫金良 孙学卿 李科伟 杨春秀 (1402)
- 溶胶-凝胶法制备 Bi₂O₃-ZnO-Nb₂O₅ 薄膜及 GaN MIS 结构 C-V 特性 舒 斌 张鹤鸣 王 青 黄大鹏 宣荣喜 (1406)
- 用分子束外延技术在 GaAs(110) 衬底上生长 AlGaAs 材料 刘林生 王文新 刘 肃 赵宏鸣 刘宝利 蒋中伟 高汉超 王 佳 黄庆安 陈 弘 周均铭 (1411)
- 具有非平面埋氧层的新型 SOI 材料的制备 郭宇锋 李肇基 张 波 刘 勇 (1415)
- 凹栅 AlGaIn/GaN HFET 张志国 冯 震 杨梦丽 冯志红 默江辉 蔡树军 杨克武 (1420)
- 单片集成 0.8 μ m 栅长 GaAs 基 InGaP/AlGaAs/InGaAs 增强/耗尽型匹配高电子迁移率晶体管 徐静波 张海英 尹军舰 刘 亮 李 潇 叶甜春 黎 明 (1424)
- 具有高压互连线的多区双 RESURF LDMOS 击穿特性 乔 明 周贤达 段明伟 方 健 张 波 李肇基 (1428)
- 4H-SiC BJT 的 Early 电压分析 韩 茹 李 聪 杨银堂 贾护军 (1433)
- GaN HEMT 器件 22 元件小信号模型 刘 丹 陈晓娟 刘新宇 吴德馨 (1438)
- 90nm MOS 器件亚阈值区 RTS 噪声幅度 鲍 立 庄奕琪 马晓华 包军林 (1443)
- RF-CMOS 建模: 一种改进的累积型 MOS 变容管模型 刘 军 孙玲玲 文进才 (1448)
- 静电驱动可调微机械电容 方东明 付 世 周 勇 赵小林 (1454)
- Si 基 SiO₂ 波导芯层热应力的理论研究 黄华茂 黄德修 刘 文 (1459)
- SU-8 胶深紫外光刻模拟 冯 明 黄庆安 李伟华 周再发 朱 真 (1465)
- CMOS 超高频整流器 周盛华 吴南健 (1471)
- 一种新颖的 D 类音频功率放大器驱动电路 叶 强 来新泉 代国定 王 辉 许录平 (1477)
- 单片集成的高性能压阻式三轴高 g 加速度计的设计、制造和测试 董培涛 李昕欣 张 鲲 吴学忠 李圣怡 封松林 (1482)
- 一种用于 14bit 50MHz 流水线模数转换器的 CMOS 采样开关 胡晓宇 周玉梅 (1488)